quartzo no equipamento de evaporação. Para obter maior exatidão nas medidas de espessura, operacionalizou-se a técnica de refletometria de raios x. Esta técnica usa um difratômetro no modo de incidência rasante para determinar espessuras de amostras maiores que 2 nm. Tendo em mãos os filmes e sua caracterização por diferentes técnica o passo seguinte foi realizar medidas de PIXE com diferentes energias, a fim de relacionar as intensidades observadas com valores de sessão de choque de ionização, e proceder à comparação com dados da literatura. Esta relação é dada por:

Nas técnicas de microanálise, a transformação da intensidade de raios x característicos em concentração do elemento considerado exige que informações do material sob análise sejam consideradas, as chamadas correções de matriz, as quais levam em conta uma série de parâmetros fundamentais. O objetivo deste trabalho é obter experimentalmente valores para um destes parâmetros, a seção de choque de ionização (uma medida da probabilidade de geração de fótons associados a uma linha característica de emissão), quando a excitação é induzida por feixe de prótons em amostras de óxidos. Neste projeto foram produzidos por evaporação induzida por feixe de elétrons (electron gun) filmes de Alumina (Al2O3), com espessuras da ordem de 10 nm, sobre um substrato de grafite. Inicialmente se usou a técnica de Rutherford Backscattering (RBS) para determinar a espessura de amostras acima de 20 nm (limite inferior de detecção da técnica) e calibrar um detector de cristal de

 $Y_{\nu} = N_{p}.n_{z}.\sigma_{\nu}.\epsilon_{\nu} \; ,$ onde Y é a intensidade de uma linha específica (v), N_{p} é o número de partículas incidentes, n_{z} esta relacionada com a espessura da amostra, σ_{v} é a seção de choque de ionização e ϵ_{v} é a eficiência de deteção para o sinal da linha v.